Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019528

International filing date: 27 December 2004 (27.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-434160

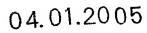
Filing date: 26 December 2003 (26.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年12月26日

出願番号

特願2003-434160

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2003-434160]

出 願 人
Applicant(s):

東洋紡績株式会社

特言 Comp Japan

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

2005年 2月18日









【書類名】 特許願 【整理番号】 A6180

 【提出日】
 平成15年12月26日

 【あて先】
 特許庁長官 殿

 【国際特許分類】
 C08G 73/22

国際特許分類】 C08G 73/24 C08G 73/14

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究

所内

【氏名】 上村 彰一

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究

所内

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究

所内

【氏名】 河原 恵造

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究

所内

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究

所内

【氏名】 吉田 武史

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究

所内

【氏名】 森野 盛雄

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究

所内

【氏名】 堤 正幸

【特許出願人】

【識別番号】 000003160

【氏名又は名称】 東洋紡績株式会社

【代理人】

【識別番号】 100080791

【弁理士】

【氏名又は名称】 高島 一

【電話番号】 06-6227-1156

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006965 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1



【包括委任状番号】 9712305



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

ベンゾオキサゾール構造を有する芳香族ジアミン類と、芳香族テトラカルボン酸無水物類とを反応させて得られるポリイミドベンゾオキサゾールからなるフィルムであって、X線回折法で測定される当該フィルムの面配向係数が $0.80\sim0.89$ である、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルム。

【請求項2】

空洞共振摂動法により測定される当該フィルムの100GHzにおける誘電正接が $0.001\sim0.03$ である請求項1記載のポリイミドベンゾオキサゾールフィルム。



【書類名】明細書

【発明の名称】ポリイミドベンゾオキサゾールフィルム

【技術分野】

[0001]

本発明は、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルム、特に高周波対応の電子部品の基材 として好適であり、かつ耐熱性に優れたポリイミドベンゾオキサゾールフィルムに関する

【背景技術】

[0002]

情報通信機器(放送機器、移動体無線、携帯通信機器等)、レーダーや高速情報処理装 置などといった電子部品の基材の材料として、従来、セラミックが用いられていた。セラ ミックからなる基材は耐熱性を有し、近年の情報通信機器の信号帯域の高周波数化(GH z帯に達する) にも対応し得る。しかし、セラミックはフレキシブルでなく、薄くできな いので使用できる分野が限定される。

[0003]

そのため、有機材料からなるフィルムを電子部品の基材として用いる検討がなされ、ポ リイミドからなるフィルム、ポリテトラフルオロエチレンからなるフィルムが提案されて いる。ポリイミドからなるフィルムは耐熱性に優れ、また、強靭であるのでフィルムを薄 くできるという長所を備える一方、高周波の信号への適用において、信号強度の低下や信 号伝達の遅れなどといった問題が懸念される。ポリテトラフルオロエチレンからなるフィ ルムは、高周波にも対応し得るが、弾性率が低いのでフィルムを薄くできない点、表面へ の金属導体や抵抗体などとの接着性が悪いという点、線膨張係数が大きく温度変化による 寸法変化が著しくて微細な配線をもつ回路の製造に適さない点等が問題となり、使用でき る分野が限定される。このように、耐熱性、高周波対応、フレキシブル性を両立した基材 用のフィルムは未だ得られていない。

[0004]

また、弾性率を高くしたポリイミドフィルムとして、ベンゾオキサゾール環を主鎖に有 するポリイミドからなるポリイミドベンゾオキサゾールフィルムが提案されている(特許 文献1参照)。このポリイミドベンゾオキサゾールフィルムを誘電層とするプリント配線 板も提案されている(特許文献2、特許文献3参照)。

【特許文献1】特開平6-56992号公報

【特許文献2】特表平11-504369号公報

【特許文献3】特表平11-505184号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

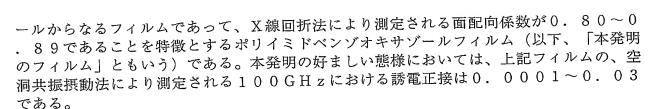
しかし、高周波への対応においては、ありふれたポリイミドベンゾオキサゾールフィル ムからなる基材の使用は、セラミックからなる基材の使用に比べて劣る。具体的には、高 周波信号の伝送効率が低く、応答速度が遅い(パルス信号の立ち上がりが悪い)ため、ポ リイミドベンゾオキサゾールフィルムを用いた回路の動作が高速化し難い。本発明は、耐 熱性、高周波対応、フレキシブル性をより高いレベルで両立した有機材料からなるフィル ムを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

本発明者らは鋭意検討した結果、特定の高次構造をもたせることによって、ポリイミド ベンゾオキサゾールフィルムの誘電正接を従来になく低くすることができ、そのようなポ リイミドベンゾオキサゾールフィルムが耐熱性、高周波対応、フレキシブル性を併せ持つ ことを見出して、本発明を完成させた。

すなわち本発明に係るフィルムは、ベンゾオキサゾール構造を有する芳香族ジアミン類 と、芳香族テトラカルボン酸無水物類とを反応させて得られるポリイミドベンゾオキサゾ



【発明の効果】

[0007]

本発明のフィルムは、従来公知のポリイミドフィルムに比べて、高周波に対してより低 損失であり、より応答速度が速いため(パルス信号の立ち上がりが良好)、このポリイミ ドベンゾオキサゾールフィルムを用いてなる回路はより高速での動作が期待できる。同時 に、従来のポリイミドフィルムより高い剛性、強度、耐熱性も有するので、高周波数化さ れた電子機器への使用やその他の電子機器への使用に好適である。特にフレキシブルな電 子回路基板の基材として有用である。

【発明を実施するための最良の形態】

[0008]

本発明のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムは、ベンゾオキサゾール構造を有する 芳香族ジアミン類と、芳香族テトラカルボン酸無水物類とを反応させて得られるポリイミ ドベンゾオキサゾールからなり、かつ、特定の高次構造(後述)をもつフィルムである。 上述の「反応」は、まず、溶媒中でジアミン類とテトラカルボン酸無水物類とを開環重付 加反応に供してポリアミド酸溶液を得て、次いで、このポリアミド酸溶液から必要に応じ てグリーンフィルムなどを成形した後に脱水縮合(イミド化)することによりなされる。

[0009]

<芳香族ジアミン類>

本発明で用いるベンゾオキサゾール構造を有する芳香族ジアミン類としては、具体的に は以下のものが挙げられる。

[0010]

【化1】

5-アミノ-2-(p-アミノフェニル)ベンゾオキサゾール

$$H_2N$$
 N N N N

[0011]

【化2】

6-アミノ-2-(p-アミノフェニル)ベンゾオキサゾール

$$H_2N$$
 O NH_2

[0012]

【化3】

5-アミノ-2-(m-アミノフェニル)ベンゾオキサゾール

$$H_2N$$
 N N N

【0013】 【化4】

6-アミノ-2-(m-アミノフェニル)ベンゾオキサゾール

【0014】

2,2'-p- フェニレンビス(5-アミノベンゾオキサゾール)

$$\mathsf{H_2N} \qquad \qquad \mathsf{N} \qquad \mathsf{NH_2}$$

【0015】

2,2'-p- フェニレンビス(6-アミノベンゾオキサゾール)

【0016】

1-(5-アミノベンゾオキサゾロ)-4-(6-アミノベンゾオキサゾロ)ベンゼン

[0017]

【化8】

2,6-(4,4'-ジアミノジフェニル)ベンゾ[1,2-d:5,4-d']ビスオキサゾール

$$H_2N$$

[0018]

【化9】

2,6-(4,4)-ジアミノジフェニル)ベンゾ[1,2-d:4,5-d] ビスオキサゾール

$$H_2N$$
 N N N N N N N N

【0019】

2,6-(3,4'-ジアミノジフェニル)ベンゾ[1,2-d:5,4-d']ビスオキサゾール

$$\mathsf{H}_2\mathsf{N} = \bigvee_{\mathsf{N}}^{\mathsf{O}} \bigvee_{\mathsf{N}}^{\mathsf{N}} \mathsf{H}_2$$

【0020】

2,6-(3,4'-ジアミノジフェニル)ベンゾ[1,2-d:4,5-d']ビスオキサゾール

$$H_2N$$

【0021】 【化12】

2,6-(3,3'-ジアミノジフェニル)ベンゾ[1,2-d:5,4-d']ビスオキサゾール

[0022]

【化13】

2,6-(3,3'-ジアミノジフェニル)ベンゾ[1,2-d:4,5-d']ビスオキサゾール

[0023]

これらの中でも、合成のし易さの観点から、アミノ(アミノフェニル)ベンゾオキサゾールの各異性体が好ましい。ここで、「各異性体」とは、アミノ(アミノフェニル)ベンゾオキサゾールが有する 2つアミノ基が配位位置に応じて定められる各異性体である(例;上記「化1」~「化4」に記載の各化合物)。これらのジアミンは、単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよい。



[0024]本発明においては、全ジアミンの30モル%以下であれば下記に例示されるベンゾオキ サゾール構造を有しないジアミン類を一種または二種以上、併用しても構わない。そのよ うなジアミン類としては、例えば、4,4'ービス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル 、ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] ケトン、ビス [4-(3-アミノフェ ノキシ)フェニル] スルフィド、ビス [4ー(3ーアミノフェノキシ) フェニル] スルホ ン、2,2-ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、mーフェニレンジアミン、oーフェニレンジアミン、pーフェニレンジアミン、 m-アミノベンジルアミン、p-アミノベンジルアミン、3, 3, -ジアミノジフェニル エーテル、3,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルエー テル、3,3'ージアミノジフェニルスルフィド、3,3'ージアミノジフェニルスルホ キシド、3, 4' ージアミノジフェニルスルホキシド、4, 4' ージアミノジフェニルス ルホキシド、3,3'ージアミノジフェニルスルホン、3,4'ージアミノジフェニルス ルホン、4, 4, ージアミノジフェニルスルホン、3, 3, ージアミノベンゾフェノン、 3, 4'ージアミノベンゾフェノン、4, 4'ージアミノベンゾフェノン、3, 3'ージ アミノジフェニルメタン、3, 4'ージアミノジフェニルメタン、4, 4'ージアミノジ フェニルメタン、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、1, 1-ビス [4-(4-r ミノフェノキシ) フェニル] エタン、<math>1, 2-ビス [4-(4-r ミノフェノキシ)フェニル] エタン、1, 1ービス [4ー(4ーアミノフェノキシ)フェニル] プロパン、1,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、1,3-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、2, 2-ビス [4-(4-ア ミノフェノキシ) フェニル] プロパン、1, 1-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フ x=x=y=1 ブタン、y=1 , y=1 , y=14-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ブタン、2 , 2-ビス [4-(4-アミノフェノシ) フェニル] ブタン、2,3-ビス[4-(4-アミノフェノキシ) フェ ニル] ブタン、2-[4-(4-r)]フェノキシ) フェニル] -2-[4-(4-r)]ノフェノキシ) -3-メチルフェニル] プロパン、2, 2-ビス [4-(4-アミノフェ ノキシ) -3-メチルフェニル] プロパン、2- [4-(4-アミノフェノキシ) フェニ , 2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) -3, 5-ジメチルフェニル] プロパン、2 2ービス [4ー (4ーアミノフェノキシ) フェニル] ー1, 1, 1, 3, 3, 3ーヘキ サフルオロプロパン、1, 4-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、44' -ビス (4-アミノフェノキシ) ビフェニル、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ケトン、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] スルフィド、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] スルホキシド、ビス [4-(4-アミノフェ ノキシ) フェニル] スルホン、ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] エーテル 、ビス[4 - (4 - アミノフェノキシ)フェニル]エーテル、1,3-ビス[4 - (4 -アミノフェノキシ) ベンゾイル] ベンゼン、1,3-ビス[4-(3-アミノフェノキシ) ベンゾイル] ベンゼン、1, 4ービス [4ー(3ーアミノフェノキシ)ベンゾイル] ベ ンゼン、4 , 4 ' -ビス [(3-アミノフェノキシ) ベンゾイル] ベンゼン、1 , 1-ビ ス [4-(3-rミノフェノキシ) フェニル] プロパン、1, 3-ビス [4-(3-r)]ノフェノキシ)フェニル]プロパン、3,4'ージアミノジフェニルスルフィド、2,2 -ビス[3-(3-rミノフェノキシ)フェニル]-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフ ルオロプロパン、ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、1, 1-ビス [4-(3-rミノフェノキシ) フェニル] エタン、1, 2-ビス [4-(3-rミノフ ェノキシ) フェニル] エタン、ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] スルホキ シド、4, 4'ービス[3-(4-アミノフェノキシ)ベンゾイル]ジフェニルエーテル 、 4 , 4 ' ービス [3ー(3ーアミノフェノキシ)ベンゾイル] ジフェニルエーテル、4



, 4' -ビス[4-(4-アミノ-α, α-ジメチルベンジル)フェノキシ]ベンゾフェ ノン、4, 4' ービス [4ー(4ーアミノーα, αージメチルベンジル)フェノキシ] ジ フェニルスルホン、ビス [4-4-4-14-14-17] スルホン、1, 4-ビス $[4-(4-アミノフェノキシ) フェノキシー<math>\alpha$, $\alpha-ジメチル$ ベンジル] ベンゼン、1, 3-ビス $\left[4-\left(4-アミノフェノキシ\right)$ フェノキシー α , α ージメチルベンジル] ベンゼン、1, 3ービス [4ー(4ーアミノー6ートリフルオロメ チルフェノキシ) $-\alpha$, α -ジメチルベンジル] ベンゼン、1, 3 -ビス [4 - (4 - Pミノー6ーフルオロフェノキシ) $-\alpha$, α ージメチルベンジル] ベンゼン、1, 3ービス 1, 3-ビス [4-(4-アミノー6-シアノフェノキシ $)-\alpha$, $\alpha-$ ジメチルベンジル] ベンゼン、3, 3' ージアミノー4, 4' ージフェノキシベンゾフェノン、4, 4' ー ジアミノー5,5'ージフェノキシベンゾフェノン、3,4'ージアミノー4,5'ージ フェノキシベンゾフェノン、3,3'ージアミノー4ーフェノキシベンゾフェノン、4, 4'ージアミノー5-フェノキシベンゾフェノン、3,4'ージアミノー4-フェノキシ ベンゾフェノン、3, 4'ージアミノー5'ーフェノキシベンゾフェノン、3, 3'ージ アミノー4, 4'ージビフェノキシベンゾフェノン、4, 4'ージアミノー5, 5'ージ ビフェノキシベンゾフェノン、3,4'ージアミノー4,5'ージビフェノキシベンゾフ ェノン、3,3'ージアミノー4ービフェノキシベンゾフェノン、4,4'ージアミノー 5-ビフェノキシベンゾフェノン、3,4'-ジアミノ-4-ビフェノキシベンゾフェノ ン、3,4'ージアミノー5'ービフェノキシベンゾフェノン、1,3ービス(3-アミ ノー4-フェノキシベンゾイル)ベンゼン、1,4-ビス(3-アミノー4-フェノキシ ベンゾイル) ベンゼン、1, 3ービス(4ーアミノー5ーフェノキシベンゾイル) ベンゼ ン、1, 4-ビス(4-アミノ-5-フェノキシベンゾイル)ベンゼン、1, 3-ビス(3-アミノー4-ビフェノキシベンゾイル) ベンゼン、1,4-ビス(3-アミノー4-ビフェノキシベンゾイル) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノ-5-ビフェノキシベン ゾイル) ベンゼン、1, 4ービス (4ーアミノー5ービフェノキシベンゾイル) ベンゼン 、2, 6ービス [4ー(4ーアミノーα, αージメチルベンジル)フェノキシ] ベンゾニ トリルおよび上記芳香族ジアミンの芳香環上の水素原子の一部もしくは全てがハロゲン原 子、炭素数1~3のアルキル基またはアルコキシル基、シアノ基、またはアルキル基また はアルコキシル基の水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換された炭素数1~ 3のハロゲン化アルキル基またはアルコキシル基で置換された芳香族ジアミン等が挙げら れる。

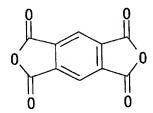
[0025]

<芳香族テトラカルボン酸無水物類>

本発明で用いられるテトラカルボン酸無水物は芳香族テトラカルボン酸無水物類である。芳香族テトラカルボン酸無水物類としては、具体的には、以下のものが挙げられる。

【0026】 【化14】

ピロメリット酸無水物



[0027]

【化15】

3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸無水物

[0028]

【化16】

4,4'-オキシジフタル酸無水物

[0029]

【化17】

3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物

[0030]

【化18】

3,3',4,4'-ジフェニルスルホンテトラカルボン酸無水物

[0031]



2,2-ビス[4-(3,4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]プロパン酸無水物

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow CH_3 \longrightarrow 0$$

[0032]

これらのテトラカルボン酸二無水物は単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよ 64

[0033]

本発明においては、全テトラカルボン酸二無水物の30モル%以下であれば下記に例示 される非芳香族のテトラカルボン酸二無水物類を一種または二種以上、併用しても構わな い。そのようなテトラカルボン酸無水物としては、例えば、ブタンー1,2,3,4ーテ トラカルボン酸二無水物、ペンタン-1,2,4,5-テトラカルボン酸二無水物、シク ロブタンテトラカルボン酸二無水物、シクロペンタン-1,2,3,4-テトラカルボン 酸二無水物、シクロヘキサンー1,2,4,5ーテトラカルボン酸二無水物、シクロヘキ サー1-エン-2,3,5,6-テトラカルボン酸二無水物、3-エチルシクロヘキサー 1-エン-3-(1,2),5,6-テトラカルボン酸二無水物、1-メチル-3-エチ ルシクロヘキサン-3-(1, 2), 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、1-メチルー 3-エチルシクロヘキサー1-エン-3-(1,2),5,6-テトラカルボン酸二無水 物、1-エチルシクロヘキサン-1-(1,2),3,4-テトラカルボン酸二無水物、 1-プロピルシクロヘキサン-1-(2 , 3) , 3 , 4-テトラカルボン酸二無水物 、1, 3ージプロピルシクロヘキサンー1-(2, 3), 3-(2, 3)ーテトラカルボン酸 二無水物、ジシクロヘキシルー3,4,3',4'ーテトラカルボン酸二無水物、ビシク ロ[2.2.1] ヘプタンー2,3,5,6ーテトラカルボン酸二無水物、1ープロピル シクロヘキサン-1-(2,3),3,4-テトラカルボン酸二無水物、1,3-ジプロ ピルシクロヘキサン-1-(2,3),3-(2,3)ーテトラカルボン酸二無水物、ジ シクロヘキシルー3, 4, 3', 4'ーテトラカルボン酸二無水物、ビシクロ[2.2. 1] ヘプタン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、ビシクロ[2.2.2] オ クタンー2,3,5,6ーテトラカルボン酸二無水物、ビシクロ[2.2.2]オクトー 7-エン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物等が挙げられる。これらのテトラ カルボン酸二無水物は単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよい。

$[0\ 0\ 3\ 4\]$

ジアミン類と、テトラカルボン酸無水物類とを重合してポリアミド酸を得るときに用い る溶媒は、原料となるモノマーおよび生成するポリアミド酸のいずれをも溶解するもので あれば特に限定されないが、極性有機溶媒が好ましく、例えば、Nーメチルー2ーピロリ ドン、N-アセチル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジエチ ルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチル ホスホリックアミド、エチルセロソルブアセテート、ジエチレングリコールジメチルエー テル、スルホラン、ハロゲン化フェノール類等があげられる。これらの溶媒は、単独ある いは混合して使用することができる。溶媒の使用量は、原料となるモノマーを溶解するの に十分な量であればよく、具体的な使用量としては、モノマーを溶解した溶液に占めるモ ノマーの重量が、通常5~40重量%、好ましくは10~30重量%となるような量が挙 げられる。

[0035]

ポリアミド酸を得るための重合反応(以下、単に「重合反応」ともいう)の条件は従来 出証特2005-3012141



[0036]

重合反応中に真空脱泡することは、良質なポリアミド酸の有機溶媒溶液を製造するのに有効である。また、重合反応の前に芳香族ジアミン類に少量の末端封止剤を添加して重合を制御することを行ってもよい。末端封止剤としては、無水マレイン酸等といった炭素一炭素二重結合を有する化合物が挙げられる。無水マレイン酸を使用する場合の使用量は、芳香族ジアミン類1モル当たり好ましくは0.001~1.0モルである。

[0037]

重合反応により得られるポリアミド酸溶液から、ポリイミドフィルムを形成するためには、ポリアミド酸溶液を支持体上に塗布して乾燥することによりグリーンフィルムを得て、次いで、グリーンフィルムを熱処理に供することでイミド化反応させる方法が挙げられる。

[0038]

ポリアミド酸溶液を塗布する支持体は、ポリアミド酸溶液をフィルム状に成形するに足る程度の平滑性、剛性を有していればよく、表面が金属、プラスチック、ガラス、磁器などであるドラムまたはベルト状回転体などが挙げられる。中でも、支持体の表面は好ましくは金属であり、より好ましくは錆びなくて耐腐食に優れるステンレスである。支持体の表面にはCr、Ni、Snなどの金属メッキを施してもよい。支持体表面は必要に応じて鏡面にしたり、あるいは梨地状に加工することができる。支持体へのポリアミド酸溶液の塗布は、スリット付き口金からの流延、押出機による押出し、スキージコーティング、リバースコーティング、ダイコーティング、アプリケータコーティング、ワイヤーバーコーティング等を含むが、これらに限られず、従来公知の溶液の塗布手段を適宜用いることができる。

[0039]

支持体上に塗布したポリアミド酸を乾燥してグリーンフィルムを得る条件は特に限定はなく、温度としては $70\sim150$ ℃が例示され、好ましくは $80\sim120$ ℃であり、乾燥時間としては、 $5\sim180$ 分間が例示され、好ましくは $10\sim120$ 分間、より好ましくは $30\sim90$ 分間である。そのような条件を達する乾燥装置も従来公知のものを適用でき、熱風、熱窒素、遠赤外線、高周波誘導加熱などを挙げることができる。次いで、得られたグリーンフィルムから目的のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムを得るために、イミド化反応を行わせる。一般には上記乾燥よりも高温での処理によりイミド化反応が進行して、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムを得ることができる。なお、本発明者らは、イミド化反応の条件により得られるフィルムの面配向係数を左右し得るという新知見を得た(後述)。

[0040]

<面配向係数>

本発明のフィルムは、X線回折法で測定される面配向係数が0.80~0.89である。フィルムの面配向係数が0.80未満であると、フィルムの誘電正接が大きくなって高周波での使用に適さない。

面配向係数とはフィルムを構成する分子の高次構造を表現するパラメーターであって、フィルムを構成する分子のうち、高い秩序性を有する結晶部分において、その構成単位である結晶格子のある特定格子面が、フィルム面に対して配向している程度を数値化したも



のである。この数値が高いほど、前記特定格子面の向きとフィルム面の向きとの差が小さ いことを意味する。本発明のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムにおける「ある特定 格子面」とは、 2 $\theta=2$ 1. 8°付近の回折ピークを与える格子面である。フィルムの面 配向係数の具体的な測定の操作は実施例の項に記載する。

一般に、フィルムの面配向係数を制御する手段としては、グリーンフィルム成膜時の昇 温プロファイルを調整したり、イミド化時に延伸を施したりする手段などが挙げられ、本 発明のフィルムにも上記手段を適用し得る。たとえば、ポリイミドベンゾオキサゾールフ ィルムの面配向係数を高くするためには、グリーンフィルムに加える熱量を小さくしたり イミド化反応中にフィルムを縦方向、横方向、あるいは縦横両方向に延伸したりする手 段が挙げられる。逆に、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの面配向係数を低くする ためには、グリーンフィルムに加える熱量を高くしたりする手段が挙げられる。また、本 発明者らは、ポリイミド前駆体(ポリアミド酸)をイミド化する際の加熱条件により、得 られるフィルムの面配向係数を制御し得るという新たな知見を見出した。

[0042]

<イミド化反応の加熱条件>

上述したように、一般にポリイミドフィルムは、ポリアミド酸溶液を乾燥して得られる グリーンフィルムを加熱してイミド化反応を行わせることによって得られる。得られるフ ィルムが上述の面配向係数を呈しやすくなるという点からは以下のイミド化が挙げられる

[0043]

イミド化の方法:熱閉環法による2段階の熱処理、

1段目の熱処理:150~250℃で1~10分間の処理、

2 段目の熱処理:4 0 0 ~ 6 0 0 ℃で 0. 1 ~ 1 5 分間の処理、

1段目の熱処理終了後から2段目の熱処理開始までの昇温条件:2~7℃/秒。

[0044]

熱閉環法とは、ポリアミド酸を加熱することでイミド化する方法である。ポリアミド酸 溶液に閉環触媒および脱水剤を含有させておいて、上記閉環触媒および脱水剤の作用によ ってイミド化反応を促進しても構わない。この方法では、ポリアミド酸溶液を支持体に塗 布した後、イミド化反応を一部進行させて自己支持性を有するフィルムを形成した後に、 加熱によってイミド化を完全に行わせることができる。

[0045]

閉環触媒をポリアミド酸溶液に加えるタイミングは特に限定はなく、ポリアミド酸を得 るための重合反応を行う前に予め加えておいてもよい。閉環触媒の具体例としては、トリ メチルアミン、トリエチルアミンなどといった脂肪族第3級アミンや、イソキノリン、ピ リジン、ベータピコリンなどといった複素環式第3級アミンなどが挙げられ、中でも、複 素環式第3級アミンから選ばれる少なくとも一種のアミンが好ましい。ポリアミド酸1モ ルに対する閉環触媒の使用量は特に限定はないが、好ましくは0.5~8モルである。

[0046]

脱水剤をポリアミド酸溶液に加えるタイミングも特に限定はなく、ポリアミド酸を得る ための重合反応を行う前に予め加えておいてもよい。脱水剤の具体例としては、無水酢酸 、無水プロピオン酸、無水酪酸などといった脂肪族カルボン酸無水物や、無水安息香酸な どといった芳香族カルボン酸無水物などが挙げられ、中でも、無水酢酸、無水安息香酸あ るいはそれらの混合物が好ましい。また、ポリアミド酸1モルに対する脱水剤の使用量は 特に限定はないが、好ましくは0.1~4モルである。脱水剤を用いる場合には、アセチ ルアセトンなどといったゲル化遅延剤を併用してもよい。

[0047]

支持体に形成されたポリイミドフィルムの前駆体(グリーンシート、フィルム)を完全 にイミド化する前に支持体から剥離してもよいし、イミド化後に剥離してもよい。

[0048]



<誘電正接>

上記のような本発明のフィルムは、高周波に対して小さな誘電正接を呈するが故に、高周波用途に適している。ここで、フィルムの誘電正接はフィルム面方向に入る信号に対して定義される。高周波対応の観点からはフィルムの誘電正接は小さい方が好ましく、空洞共振摂動法により測定される本発明のフィルムの100GHzにおける誘電正接は、好ましくは0.03以下であり、より好ましくは0.02以下であり、更に好ましくは0.01以下である。本発明のフィルムの100GHzにおける誘電正接は小さい方が好ましく、その下限は特に定められるものではないが、フィルム製造上の観点から、例えば0.001が挙げられる。本発明では、フィルムの誘電正接を空洞共振振動法により測定する。具体的な測定の操作は実施例の項に記載する。

[0049]

本発明者らは、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの面配向係数の制御により当該フィルムの誘電正接を制御し得ることを新たに見出した。その他にフィルムの誘電正接を制御し得る手段には、イミド化せずにポリアミド酸のままフィルムに残る化合物の割合(以下、「未反応ポリアミド酸の割合」ともいう)を調整したり、フィルムの密度を調整したりする手段が挙げられる。たとえば、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの誘電正接を高くするためには、未反応ポリアミド酸の割合を高くしたり、フィルムの密度を低くしたりする手段が挙げられる。逆に、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの誘電正接を低くするためには、未反応ポリアミド酸の割合を低くしたり、フィルムの密度を高くしたりする手段が挙げられる。

[0050]

本発明のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの厚さは特に限定されないが、電子基板の基材に用いることを考慮すると、通常 $1\sim150\,\mu\,\mathrm{m}$ 、好ましくは $3\sim50\,\mu\,\mathrm{m}$ である。この厚さはポリアミド酸溶液を支持体に塗布する際の塗布量や、ポリアミド酸溶液の濃度によって容易に制御し得る。

[0051]

本発明のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムは、通常は無延伸フィルムであるが、 1軸または2軸に延伸しても構わない。ここで、無延伸フィルムとは、テンター延伸、ロ ール延伸、インフレーション延伸などによってフィルムの面拡張方向に機械的な外力を意 図的に加えずに得られるフィルムをいう。

【実施例】

[0052]

以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の実施例によって限定されるものではない。なお、以下の実施例における物性の評価方法は以下の通りである。

[0053]

1. ポリアミド酸の還元粘度 (η s p / C)

ポリマー濃度が0.2g/d1となるようにN-メチルー2-ピロリドンに溶解した溶液をウベローデ型の粘度管により30℃で測定した。

[0054]

2. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの厚さ

マイクロメーター(ファインリューフ社製、ミリトロン1245D)を用いて測定した

[0055]

3. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの引張弾性率、引張破断強度および破断伸度 測定対象のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムを、流れ方向(MD方向)および幅 方向(TD方向)にそれぞれ100mm×10mmの短冊状に切り出したものを試験片とした。引張試験機(島津製作所製、オートグラフ(R) 機種名AG-5000A)を用い、引張速度50mm/分、チャック間距離40mmの条件で、MD方向、TD方向それぞれについて、引張弾性率、引張強度及び破断伸度を測定した。



[0056]

4. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの線膨張係数 (CTE)

測定対象のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムについて、下記条件にてMD方向およびTD方向の伸縮率を測定し、30 \mathbb{C} $\mathbb{$

装置名 ; MACサイエンス社製TMA4000S

試料長さ ; 20mm 試料幅 ; 2mm 昇温開始温度 ; 25℃ 昇温終了温度 ; 400℃ 昇温速度 ; 5℃/min

雰囲気 ; アルゴン

[0057]

5. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの融点、ガラス転移温度

測定対象のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムについて、下記条件で示差走査熱量測定 (DSC) を行い、融点 (融解ピーク温度Tpm) とガラス転移点 (Tmg) を JI S K 7121に準拠して求めた。

装置名 ; MACサイエンス社製DSC3100S

パン ; アルミパン (非気密型)

試料重量 ; 4 m g 昇温開始温度 ; 3 0 ℃ 昇温終了温度 ; 6 0 0 ℃ 昇温速度 ; 2 0 ℃/min

雰囲気 ; アルゴン

[0058]

6. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの熱分解温度

測定対象のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムを充分に乾燥したものを試料として、下記条件で熱天秤測定 (TGA) を行い、試料の重量が5%減る温度を熱分解温度とみなした。

装置名 ; MACサイエンス社製TG-DTA2000S

パン ; アルミパン(非気密型)

試料重量 ; 10mg 昇温開始温度 ; 30℃

昇温速度 ; 20℃/min

雰囲気 ; アルゴン

[0059]

7. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの面配向係数

測定対象のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムを測定治具に装着して以下の条件にてX線回折測定を行って、 $2\theta=21.8$ °付近に現れる回折ピークについての極点図を求めた。

装置名 ; (株) リガク製RINT 2100PC、多目的試料台

電圧、電流値 ; 40kV、40mA 測定法 ; 反射法および透過法

走香範囲 ; 反射法 α ; $15 \sim 90^{\circ} / 2.5^{\circ}$ 間隔

β;0~360°/5°間隔

反射法 α ; $0 \sim 1.5^{\circ}$ / 2.5° 間隔 β ; $0 \sim 3.60^{\circ}$ / 5° 間隔

スリット ; DS 0.1mm、SS 7mm、RS 7mm、

縦発散制限スリット 1.2 mm



走査スピード ;連続 (360°/min) 検出器 ;シンチレーションカウンター

[0060]

図1は、この極点図を模式的に表したものである。図中、2本の破線部における回折強度プロファイルからピーク半値幅(H_{M} D および H_{T} D)を求め、 H_{M} D および H_{T} D の平均値をH a(単位:。)と定義した。尚、ピーク半値幅は、リガク製解析プログラムを用いて求めた。このようにして得られたH a から、ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの面配向係数を次式により算出した。

面配向係数 = (180° - Ha)÷180°

[0061]

- 8. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの体積抵抗率
 - JIS C2318準拠の方法にて、体積抵抗率を測定した。

[0062]

- 9. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの絶縁破壊電圧
 - JIS C2318準拠の方法にて、絶縁破壊電圧を測定した。

[0063]

10. ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの誘電正接

(試験片の作製)

ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムを、必要厚みになる枚数重ね、 $300 \, \mathrm{kg} \, \mathrm{f} / \mathrm{cm}^2$ の荷重を加えて圧着して 1. $6 \, \mathrm{mm} \times 1$. $5 \, \mathrm{mm} \times 7 \, 5 \, \mathrm{mm}$ の角柱状試験片を作製した。

(試験片の測定)

上記試料についてアジレントテクノロジ社製、N5250Aミリ波PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザを用い、空洞共振摂動法により1GHz、10GHz、100GHzでの比誘電率、誘電正接を測定した。

[0064]

(ポリアミド酸溶液の調製)

窒素導入管、温度計、攪拌棒を備えた反応容器内を窒素置換した後、500重量部の5-アミノー2ー(p-アミノフェニル)ベンゾオキサゾールを入れた。次いで、5000重量部のN-メチルー2-ピロリドンを加えて完全に溶解させてから、485重量部のピロメリット酸二無水物を加えて、25 $\mathbb C$ にて15 時間攪拌すると、褐色の粘調なポリアミド酸溶液が得られた。この還元粘度(η s p / $\mathbb C$)は2.0 であった。

[0065]

(ポリアミド酸のグリーンフィルムの製造)

このポリアミド酸溶液をステンレスベルトにコーティングし(スキージ/ベルト間のギャップは、 650μ m)、90 ∞ にて60 分間乾燥した。乾燥後に自己支持性となったポリアミド酸フィルムをステンレスベルトから剥離して、厚さ 40μ mのグリーンフィルムを得た。

[0066]

(ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの製造)

得られたグリーンフィルムを、窒素置換された連続式の熱処理炉に通し、表 1 記載の条件で 2 段階の加熱を施して、イミド化反応を進行させた。その後、5 分間で室温にまで冷却することで、褐色を呈する実施例 $1\sim2$ 、比較例 $1\sim3$ のポリイミドベンゾオキサゾールフィルムを得た。得られた各ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムの測定結果を表 1 に記載する。

[0067]



【表1】

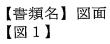
		実施例	実施例	比較例	比較例	比較例
		1	2	1	2	3
株 一段目	温度(℃)	170	200	170	200	1 3 0
	時間(分)	3	2	3	1	3
台 首海庫(℃/秒)		3	6	0.5	3	2
7	温度(℃)	450	500	380	380	450
グ 二段目	時間(分)	7	1	5	1 0	5
厚さ (μm)		2 5	2 5	2 5	2 5	2 5
引張弾性率	MD	7.9	9.0	4.1	7.5	6.2
(GPa)	TD	7.9	9.0	3.9	7.2	6.1
引張破断強度 MD		350	380	300	3 5 0	280
(MPa)	TD	3 4 0	370	280	3 1 0	250
破断伸度	MD	2 5	2 5	5 8	47	2 0
(%) T D		2 4	2 4	5 5	4 4	15
線膨張係数	MD	6	5	2 4	17	1 2
(ppm) TD		5	4	2 0	1 5	10
融点 (℃)		無	無	無	無	無
ガラス転移温度 (℃)		無	無	無	無	無
熱分解温度 (℃)		6 1 0	620	590	620	5 9 0
面配向係数		0.82	0.87	0.75	0.78	0.77
体積抵抗率 (×10 ¹⁶ Ωcm)		1. 5	2. 0	0.9	1. 0	1.0
絶縁破壊電圧(kV)		6.8	6.5	4.2	3.8	5.1
心心以及我已	1 G H z	3.0	2.8	3.2	3.1	3.2
比誘電率	10 G H z	2.9	2.7	3.0	3.0	3.1
	100GHz	2.8	2.7	2.9	2.9	3.1
誘電正接	1 G H z	0.008	0.006	0.060	0.041	0.060
	10 G H z	0.006	0.004	0.058	0.035	0.051
	100GHz	0.002	0.001	0.050	0.032	0.045

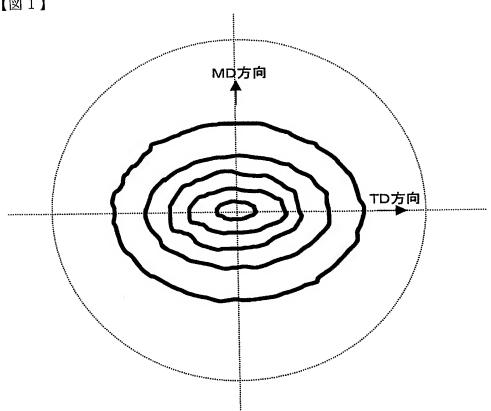
【図面の簡単な説明】

[0068]

【図1】ポリイミドベンゾオキサゾールフィルムのX線回折極点図を模式的に表す。









【書類名】要約書

【要約】

【課題】 耐熱性、高周波対応、フレキシブル性をより高いレベルで両立した有機材料からなるフィルムを提供すること。

【解決手段】 ベンゾオキサゾール構造を有する芳香族ジアミン類と、芳香族テトラカルボン酸無水物類とを反応させて得られるポリイミドベンゾオキサゾールからなるフィルムであって、X線回折法で測定される当該フィルムの面配向係数が $0.80\sim0.89$ であり、空洞共振摂動法により測定される100GHzにおける誘電正接が、好ましくは $0.001\sim0.03$ であるポリイミドベンゾオキサゾールフィルム。

【選択図】 なし



特願2003-434160

出願人履歴情報

識別番号

[000003160]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月10日

更埋田」 住 所 新規登録 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

氏 名 東洋紡績株式会社